PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

11-242995

(43)Date of publication of application: 07.09.1999

(51)Int.CL

H05B 33/14 CO9K 11/06

(21)Application number: 10-350316

(22)Date of filing:

09.12.1998

(71)Applicant: MITSUI CHEM INC

(72)Inventor: NAKATSUKA MASAKATSU

KITAMOTO NORIKO

(30)Priority

Priority number : 09343158

Priority date: 12.12.1997

Priority country: JP

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve luminous efficiency and luminance by forming a structure by holding at least one layer containing one or more kinds of bisnaphtho[1'.8':5.6.7]-s-indaceno[1.2.3-cd:1'.2'.3'c'.d']benzo[1,2-k:4,5-k']difluoranthene derivatives

between a pair of electrodes.

SOLUTION: This derivative has a framework expressed by a formula and is structured by substituting a predetermined halogen atom group, alkoxyl group, aryl group or the like for one or more out of 30 hydrogen atoms, and an organic electroluminescent element using it for its luminescent layer emits red-colored light that is high in luminance and excellent in durability. A layer containing the derivative contains a luminous organic metal complex including aluminum and the like or a triallylamine derivative and may have a hole injection/transfer layer and/or an electron injection/transfer layer between a pair of electrodes. If

the luminescent layer is formed by combining it with

another luminous ingredient, white-colored light that is high in luminance and excellent in durability can be also emitted.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22 07 2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

Searching PAJ 2/2 ページ

[Patent number]
[Date of registration]

3690926 24.06.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (II)特許出願公開番号

特開平11-242995

(43)公開日 平成11年(1999)9月7日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	FΙ		
H 0 5 B	33/14		H 0 5 B	33/14	В
C 0 9 K	11/06	610	C09K	11/06	610

審査請求 未請求 請求項の数7 ○1. (全42頁)

	平10-350316 10年(1998)12月9日	(71) 出順人	000003887 三井化学株式会社 東京都千代田区講が限三 F目 2 番 5 号
(22) 出顧日 平成	10年(1998)12月9日		
(22) 引顧日 平成	10年(1998)12月9日		WATER CONTRACTOR OF THE
			果泉都十代田区境が関ニ」日と番5万
		(72)発明者	中域で下勝
(31)優先権主張番号 特願	¥9−343158		神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井
	(1997)12月12日		化学株式会社内
	(JP)	(72)発明者	北本 典子
(33) 使兀相土武国 日本	(3 F)	(14)369141	
			神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井
			化学株式会社内

(54) 【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】

【解決手段】 一対の電極間に、ビスナフト[1',8':5, 6,7]-s-インダセノ[1,2,3-cd:1',2',3'-c',d'] ベンゾ [1,2-k:4,5-k']ジフルオランテン誘導体を少なくとも1 種含有する層を少なくとも1層挟持してなる有機電界発 光素子。

【効果】 発光輝度が優れた有機電界発光素子を提供す 3.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に、ビスナフト[1'.8':5, 6,71-s-インゲセノ[1,2,3-cd:1',2',3'-c'd']ペンゾ[1, 2-k:4,5-k']ジフルオランテン誘導体を少なくとも1種 含有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光 套子.

【請求項2】 ビスナフト[1',8':5,6,7]-s-インダセノ [1,2,3-cd:1',2',3'-c'd']ペンゾ[1,2-k:4,5-k']ジフル オランテン誘導体を少なくとも1報合有する層が、発光 層である誘求項1計載の有機電界発光素子。

【請求項3】 ビスナフト(1'.8':5.6.7)-s-インダセノ (1.2,3-cd:1'.2'.3'-c'd')ペンゾ(1.2*に4.5-k')ジフル オランテン誘導体を少なくとも1種含有する層が、さら に発光性有機金属錯体を含有する請求項1または2記載 の右機需異発半巻子.

【請求項4】 ビスナフト[1',8':5,6,7]-s-インダセノ

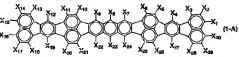
[1,2,3-cd:1',2',3'-c'd']ベング[1,2-k:4,5-k']ジフル オランテン誘導体を少なくとも1種含有する層が、さら にトリアリールアミン誘導体を含有する請求項1または 2計載の有機需果発光素子。

【請求項5】 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送 層を有する請求項1~4のいずれかに記載の有機電界発 米素子.

【請求項6】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送 層を有する請求項1~5のいずれかに記載の有機電界発 光素子。

【請求項7】 ビスナフト[1'.8':5,6,7]-s-インダセノ [1,2,3-cd:1'.2'.3'-c'd']ペンゾ[1,2-k:4,5-k']ジフル オランテン誘導体が一般式 (1-A) (化1) で表され る化合物である請求項1~6のいずれかに記載の有機電 界発光業子。

【化1】



(式中、 $X_1 \sim X_{30}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分較または現状のアルキル基、直鎖、分較または現状のアルコキン基あるいは置換または未置換のアリール基を表し、 $X_1 \sim X_{30}$ から選ばれる互いに隣接する基、 $X_2 \in X_{30}$ は、および $X_2 \in X_{30}$ は互いに結合して、置換している炭素原子と共に、置換さたは未置換の炭素原末肺肪族環を形成していてもよい。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子 に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バ ックライトなどのパネル型光源として使用されてきた が、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要 である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機 電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有 機EL素子)が開発された [Appl. Phys. Lett., 51、 913 (1987) 〕、有機電界発光素子は、蛍光性有機化合物 を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、 該薄膜に電子および正孔(ホール)を注入して、再結合 させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、こ の励起子が失活する際に放出される光を利用して発光す る素子である。有機電界発光素子は、数V~数十V程度 の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機 化合物の種類を選択することにより、種々の色(例え ば、赤色、青色、緑色) の発光が可能である。このよう な特徴を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、

表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、 一般に、発光輝度が低く、実用上充分ではない。

【0003】発光輝度を向上させる方法として、例えば、発光層として、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムをホスト化合物、クリン誘導体、とラン誘導体、とラン誘導体、とラン誘導体、とラン誘導体、とラン誘導体、とラン誘導体、65、3610(1989)〕。また、発光層として、例えば、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(4ーフェニルフェノラート)アルミニウムをホスト化合物、アクリドン誘導体(例えば、Nーメチルー2ーメトキシアクリドン・シスト化合物は1、Nーメチルー2ーメトキシアクリドン)をスト化合物として用いた有機電界発光素子が頻繁されている(特開下8ー67873号公報)。しかしながら、これらの発光素子も充分交発光輝度を有しているとは言い難い。現在では、一層高輝度に発光する有機電界発光素子が現ままります。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光 効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光素子を提供 することである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界 発光素子、および該業子に使用する化合物に関して鋭意 検討した結果、本発明を完成するに至った。すなわち、 本発明は、

の一対の電極間に、ビスナフト[1',8':5,6,7]-s-インダセノ[1,2,3-cd:1',2',3'-c'd')ペンゾ[1,2-x:4,5-k']ジフルオランテン誘導体を少なくとも1種合有する層を少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、

● ビスナフト(1',8':5,6,7)-s-インダセノ(1,2,3-cd: 1',2',3'-c'd')ベンゾ(1,2-k:4,5-k')ジフルオランテン 誘導体を少なくとも1種含有する層が、発光層であるΦ 記載の有機電界発光素子、

◎ ビスナフト[1',8':5,6,7]-s-インダセノ[1,2,3-cd: 1',2',3'-c'd']ベンゾ[1,2-k:4,5-k']ジフルオランテン 誘導体を少なくとも1種含有する層が、さらに発光性有機金属錯体を含有するΦ またはΦ 記載の有機電界発光素 子

● ビスナフト[1',8':5,6,7]-s-インダセノ[1,2,3-cd: 1',2',3'-c'd']ベンゾ[1,2-x:4,5-k']ジフルオランテン誘誘帯体を少なくとも1種含有する層が、さらにトリアリールアミン誘導体を含有する○または○記載の有機電界等光素子。

● 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する前記記Φ ~● のいずれかに記載の有機電界発光素子、

●一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記
 □ ● のいずれかに記載の有機電界発光素子、

の ビスナフト[1',8':5,6,7]-s-インダセノ[1,2,3-cd: 1',2',3'-c'd')ベンゾ[1,2-x:4,5-k']ジフルオランテン 誘導体が一般式 (1 − A) (化2) で表される化合物である前記²⁰ へのいずれかに記載の有機電界発光素子、に関するものである。

【0007】 【化2】

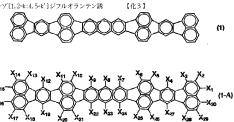
(式中、 $X_1 \sim X_{30}$ はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または東位のアリール基を表し、 $X_1 \sim X_{30}$ から選ばれる互いに隣接する基、 $X_2 \sim X_{30}$ から選ばれる互いに隣接する基、 $X_2 \sim X_{30}$ に対して、電換している炎素原子と共に、置換の火素環に脂肪族環を形成していてもよい。

[8000]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明 する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、 ビスナフト[1'.8':5,6,7]-s-インダセノ[1,2,3-cd:1'、 2'.3'-c'd']ベンゾ[1,2-k:4.5-k']ジフルオランテン誘 導体を少なくとも1種含有する層を少なくとも一層挟持してなるものである。

【0009】本発明に係るビスナフト[1'.8':5.6.7] ニインダセン[1.2,3-cd:1'.2',3'-c'd'] ベンン[1.2-k:4.5 たパラントン詩簿庫は(以下、本発明に係る化合物Aと略記する)は、一般式(1)(化3)で表される情格を有する化合物を表すものであり、一般式(1)で表される情格には、種々の置換基を有していてもよく、好ましくは、一般式(1-A)(化3)で表される化合物である。

[0010]



(式中、X, ~X₃oはそれぞれ検立に水素原子、ハロゲン原子、庭鎮、分峻または環状のアルキル基、庭鏡、分峻または環状のアルキル基、医鏡または未産機のアリール基を表し、X: ~X₃oから選ばれる互いに隣接する基、X, ~X₅o、およびX。とX₂はよ互いに結合して、 産換している炭素原子と共に、置換または未置換の炭素 環式脂肪族類を形成していてもよい。)

 $\{00111\}$ 一般式(1-A)で表される化合物において、 $X_1 \sim X_2$ 。はそれぞれ独立に水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表し、さらに、 $X_1 \sim X_2$ 。から選ばれる互いに開接する基、 $X_2 \in X_3$ 。、および $X_2 \in X_2$ 。に結合して、置換している炭素原子と共に、置換または、未置換の炭素環式脂肪族環を形成していてもよいを表す。尚、本願発明において、アリール基とは、例えば、フェニル基、ナフチル基などの炭素環式芳香族基、例えば、フリル基、チエニル基、ビリジル基などの機業環式芳香族基を変し

【0012】一般式(1-A)で表される化合物において、より好ましくは、×、~~×36は木素原子、ハロゲン原子、炭素敷1~24の直鎖、分岐または環状のアルコル基、炭素敷1~24の直鎖、分岐または環状のアルコキン基、あるいは炭素敷4~24の置換または未置換のアリール基を表す。

【0013】一般式(1-A)における、X1~X30の 具体例としては、例えば、水素原子、例えば、フッ素原 子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、例えば、 メチル基、エチル基、n-プロビル基、イソプロビル 基、n-ブチル基、イソブチル基、sec -ブチル基、te rtーブチル基、nーペンチル基、イソペンチル基、ネオ ペンチル基、tert-ペンチル基、n-ヘキシル基、1-メチルペンチル基、4-メチル-2-ペンチル基、3, 3-ジメチルブチル基、2-エチルブチル基、n-ヘプ チル基、1-メチルヘキシル基、シクロヘキシルメチル 基、n-オクチル基、tert-オクチル基、1-メチルへ プチル基、2~エチルヘキシル基、2-プロビルペンチ ル基、n-ノニル基、2,2-ジメチルヘプチル基、 2.6-ジメチル-4-ヘプチル基 3.5.5-トリ メチルヘキシル基、n-デシル基、n-ウンデシル基、 1-メチルデシル基、n-ドデシル基、n-トリデシル 基、1-ヘキシルヘプチル基、n-テトラデシル基、n ペンタデシル基、nーヘキサデシル基、nーヘプタデ シル基、n-オクタデシル基、n-エイコシル基、n-トリコシル基、nーテトラコシル基、シクロベンチル 基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基、 4-tert-ブチルシクロヘキシル基、シクロヘプチル 基、シクロオクチル基などの直鎖、分岐または環状のア ルキル基

【0014】例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-ブ

ロボキシ基 (ソプロボキシ基、n-ブトキシ基、y フトキシ基、y アトキン基、y アトキン基、y アトキン土、y アルオキシ基、y アルオキン基、y アルオ・y アルオ・y

【0015】例えば、フェニル基、2-メチルフェニル 基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、3 -エチルフェニル基、4-エチルフェニル基、4-n-プロピルフェニル基、4-イソプロピルフェニル基、4 - n - ブチルフェニル基、4 - イソブチルフェニル基、 4-tert-ブチルフェニル基、4-n-ペンチルフェニ ル基、4-イソペンチルフェニル基、4-tert-ペンチ ルフェニル基、4-n-ヘキシルフェニル基、4-シク ロヘキシルフェニル基、4-n-ヘプチルフェニル基、 4-n-オクチルフェニル基、4-n-ノニルフェニル 基、4-n-デシルフェニル基、4-n-ウンデシルフ ェニル基、4-n-ドデシルフェニル基、4-n-テト ラデシルフェニル基、4-n-ヘキサデシルフェニル 基、4-n-オクタデシルフェニル基、2,3-ジメチ ルフェニル基、2、4-ジメチルフェニル基、2、5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、 3,4-ジメチルフェニル基、3,5-ジメチルフェニ ル基、3,4,5-トリメチルフェニル基、2,3, 5.6-テトラメチルフェニル基.5-インダニル基. 1,2,3,4-テトラヒドロ-5-ナフチル基、1, 2,3,4-テトラヒドロ-6-ナフチル基、2-メト キシフェニル基、3-メトキシフェニル基、4-メトキ シフェニル基、3-エトキシフェニル基、4-エトキシ フェニル基、4-n-プロボキシフェニル基、4-イソ プロボキシフェニル基。4-n-ブトキシフェニル基。 4-イソブトキシフェニル基、4-n-ペンチルオキシ フェニル基、4-n-ヘキシルオキシフェニル基、4-シクロヘキシルオキシフェニル基、4-n-ヘプチルオ キシフェニル基、4-n-オクチルオキシフェニル基、 4-n-ノニルオキシフェニル基、4-n-デシルオキ シフェニル基、4-n-ウンデシルオキシフェニル基、 4-n-ドデシルオキシフェニル基、4-n-テトラデ シルオキシフェニル基、4-n-ヘキサデシルオキシフ ェニル基、4-n-オクタデシルオキシフェニル基、 【0016】2、3-ジメトキシフェニル基、2、4-ジメトキシフェニル基、2,5-ジメトキシフェニル

基、3、4-ジメトキシフェニル基、3、5-ジメトキ シフェニル基、3、5-ジエトキシフェニル基、2-メ トキシ-4-メチルフェニル基、2-メトキシ-5-メ チルフェニル基、3-メトキシ-4-メチルフェニル 基、2-メチル-4-メトキシフェニル基、3-メチル -4-メトキシフェニル基、3-メチル-5-メトキシ フェニル基、2-フルオロフェニル基、3-フルオロフ ェニル基、4-フルオロフェニル基、2-クロロフェニ ル基、3-クロロフェニル基、4-クロロフェニル基、 4-ブロモフェニル基、4-トリフルオロメチルフェニ ル基、2,4-ジフルオロフェニル基、2,4-ジクロ ロフェニル基、3、4-ジクロロフェニル基、3、5-ジクロロフェニル基、2-メチル-4-クロロフェニル 基、2-クロロ-4-メチルフェニル基、3-クロロー 4-メチルフェニル基。2-クロロ-4-メトキシフェ ニル基、3-メトキシ-4-フルオロフェニル基、3-メトキシー4-クロロフェニル基、3-フルオロ-4-メトキシフェニル基、4-フェニルフェニル基、3-フ ェニルフェニル基、4-(4'-メチルフェニル)フェ ニル基、4-(4'-メトキシフェニル)フェニル基、 1-ナフチル基、2-ナフチル基、4-メチル-1-ナ フチル基、4-エトキシ-1-ナフチル基、6-n-ブ チルー2ーナフチル基、6-メトキシー2-ナフチル 基、7-エトキシ-2-ナフチル基、2-フリル基、2 ーチエニル基、3ーチエニル基、2ーピリジル基、3ー ピリジル基、4-ピリジル基などの置換または未置換の アリール基を挙げることができ、より好ましくは、水素 原子、フッ素原子、塩素原子、炭素数1~20の直鎖、 分岐または環状のアルキル基、炭素数1~20の直鎖。 分岐または環状のアルコキシ基、あるいは炭素数6~2 0のアリール基であり、さらに好ましくは、水素原子、 炭素数1~16の直鎖、分岐または環状のアルキル基、

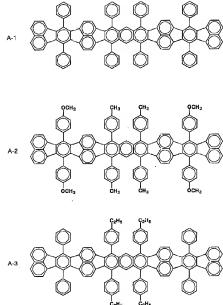
あるいは炭素数6~20の置換または未置換のアリール 基である。

【0018】一般式(1-A)において、 X_1 、 X_2 、 X_3 、 X_1 2、 X_2 2、 X_2 4および X_2 7が埃素数1-A0の直鎖、分岐または環形のアルキル港。あるいは炭素数 $6\sim2$ 0の置換または未置換のアリール基であり、且つその他のXが水素原子である化合物がより好まし

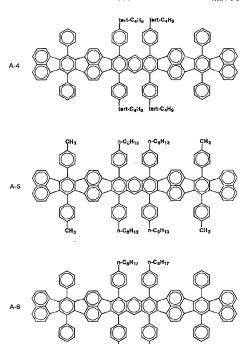
【0019】本発明の有機電料発光票子においては、ビスナフト(1.8:56.07)s-イングセノ(1.2)-dci1'.2'、マイリへン(1.2+は-5年)ジラルオラン・洗薄体を少なくとも1種使用することが特徴であり、例えば、ビスナフト(1'.8:56.07)s-イングセノ(1.2.3-dci1')、2'3-dci1'ンン/(1.2+5+2)ジラルオランテン誘導体を発光成分として発光層に用いると、従来にはない、高輝度で耐火性に優れた赤色に発光する有機電界系光素子を提供することが可能となる。また、個の発光成分と出み合わせて発光層を形成すると、高輝度で耐久性に優れた白色に発光する有機電界発光素子も提供することが可能となる。

【0020】本発明に係る化合物Aの具体例としては、例えば、以下の化合物(化4~化27)を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。 【0021】 【化4】

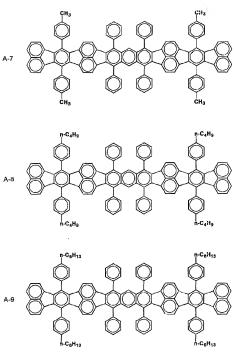
例示化合物番号



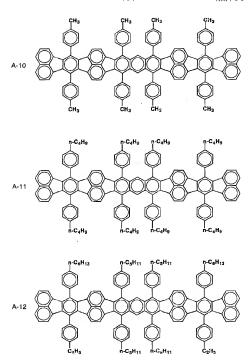
[0022] [425]



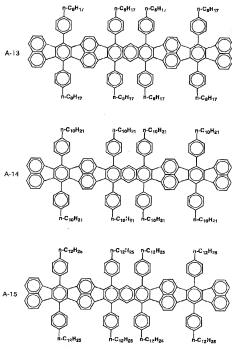
[0023] [化6]



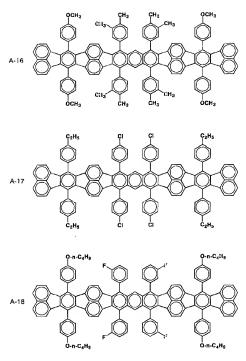
【0024】 【化7】



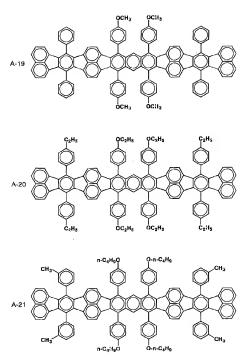
[0025] [化8]



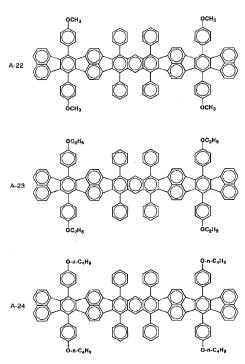
[0026] [化9]



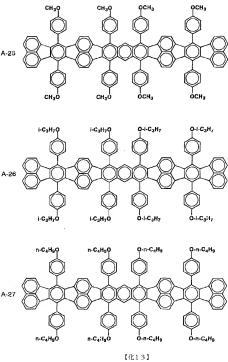
[0027] 【化10】



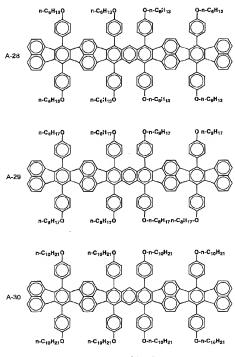
[0028] [化11]



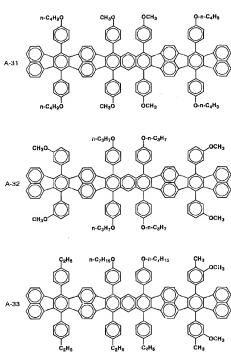
[0029] 【化12】



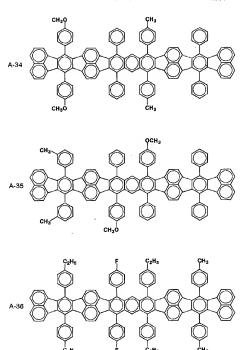
[0030]



[0031] [化14]

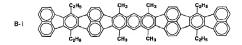


【0032】 【化15】



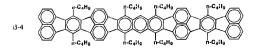
[0033] [化16]

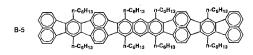
例示化合物番号



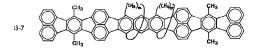
•

[0034] [化17]





[0035]



13-B

【0036】 【化19】

例示化合物番号

[0037] [化20]

[0038] [他21]

【0039】 【化22】

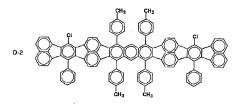
[0040] [423]

【化24】

[0041]

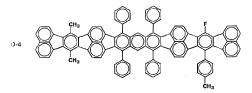
【0042】 【化25】

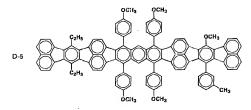


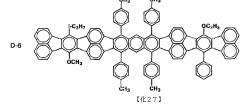




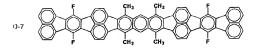
[0043] [他26]

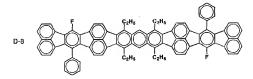






[0044]





【0045】本発明に係る化合物A、例えば、一般式 (1-A)で表される化合物は、それ自体公知の方法 (例えば、Angeov. Chem. Int. Ed. Engl., 36、199 (1997)に記載の方法)に従って製造することができ る。すなわち、例えば、一般式(2)(化28)で表さ れる化合物に、一般式 (3) (化28) で表される化合物、および一般式 (4) (化28) で表される化合物を作用させることにより製造することができる。 【0046】 【化28】

$$X_{14}$$
 X_{15}
 X_{15}
 X_{15}
 X_{15}
 X_{17}
 X_{18}
 X_{19}
 X_{19}
 X_{19}
 X_{19}

〔上式中、 $X_1 \sim X_{30}$ は一般式(1-A)と同じ意味を表す。〕

【0047]尚、一般式(2)で表される化合物は、それ自体公知の方法(例えば、Angew、Chem. Int. Ed. Eng. 1.,36,1996(1997)、Synlett、75(1994)に記載の方法)に従って製造することができる。すなわち、一般式(5)(化29)で表される化合物と一般式(6)(化29)で表される化合物、および一般式(7)(化29)で表される1.4 一ペンザジイン誘導体を作用させて製造することができる。

【0048】 【化29】

(上式中、X₆、~X₁₁、およびX₂₆~X₂₆は-根式(1 -A)と同じ意味を表す。] [0049]尚、一般式(3)および一般式(4)で表 されるシクロペンタ(3)アセナフチレン-8-オン誘導 体は、其自体公知の方法(例えば、Chem. Rev.・65、67 (1965)に記載の方法)に従って製造することができ る.

【〇〇50】尚、本発明に係る化合物A、例えば、一般式(1-A)で表される化合物は、場合により使用した 落線(例えば、トルエンなどの芳香族炎化未蒸高端)との溶媒和物を形成した型で製造されることがあるが、 本発明の有機電界発光業子には、本発明に係る化合物A の無溶媒和制な物論、このような溶媒和物をも使用する ことができる。本発明に係る化合物A、例えば、一般式 (1-A)で表される企物を、有機電界光光素子の 用する場合、再結晶法、カラムクロマトグライー法、 昇華精製法などの精製方法、あるいはこれらの方法を併 用して、純度を高めた化合物を使用することは好ましい ことである。

【0051】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間 に、少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を、少 なくとも一層挟持してなるものである。発光層に使用す る化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電 子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注 入輸送成分を含有する正孔注入輸送層および/または電 子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けること もできる。例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入 機能、正孔輸送機能および/または電子注入機能、電子 輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層お よび/または電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成と することができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸 送層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素 子(一層型の素子)の構成とすることもできる。また、 正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞ れの層は、一層構造であっても多層構造であってもよ く、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれ の層において、注入機能を有する層と輸送機能を有する 層を別々に設けて構成することもできる。

[0052]本発明の有機電界発光業子において、本発 明に係る化合物Aは、正孔注入輸送成分、発光成分また は電子注入輸送成分に用いることが射ましく、正孔注入 輸送成分または発光成分に用いることがはり好ましく、 発光成分に用いることが特に好ましい。本発明の有機電 発光光素子においては、本発明に係る化合物Aは、単独 で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0053】本発明の有機電界発光素子の構成として は、特に限定するものではなく、例えば、(A) 陽極/ 正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/降極型素子 (図1)、(B) 陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極 型素子(図2)、(C) 陽極/発光層/電子注入輸送層/ 陰極型素子(図3)、(D) 陽極/発光陽/陰極型素 子(図4)などを挙げることができる。さらに 層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E) 陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子 注入輸送層/整位型素子(図5)とこともできる。 (D) 郷の素子構成としては、発光成分を一層形態で一 対の電整間に挟持させた型の業子は勿論であるが、さら には、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光成分およ び電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電 間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送 成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極 間に挟持させた型の素子(図7)、(H)発光成分およ び電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極 間に挟持させた型の素子(図8)がある。

【0054】本発明の有機電界発光素子においては、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の柔子において、正孔注入輸送層。 光光層、電子法入輸送層 を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層を発光層との間に、正孔注入輸送成分を発光波分の混合層と近げ、または発光緩上電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(F)型素子、

(G) 型素子または(H) 型素子であり、さらに好ましくは、(A) 型素子、(B) 型素子、(C) 型素子または(F) 型素子である。

【0055】本発明の有機電界発光素子としては、例えば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子について説明する。

(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入 輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、 7は電源を示す。

【0056】本発明の有機電界発光業子は、基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、適明ないし半適明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明アラスチックシート(例えば、ボリエステル、ボリカーボネート、ボリスルフォン、ボリメチルメタクリレート、ボリブロビレン、ボリエチレンなどのシート)、半透明プラスチックシート、石疾、透明セラミックスカるいはこれんを組み合わせた複合シートからなるものを挙げることができる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコントロールすることもできる。

【0057】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが考ましい、陽極に使用する電金物物質として は、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、 バラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化 亜鉛、ITO(インジウム・ティン・オキサイド)、ボ リチオフェン、ボリビロールなどを挙げることができ る。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、ある いは複数作用してもよい。陽極は、これらの電極物質 を、例えば、素着法、スパッタリング法等の方法によ り、基板の上に形成することができる。また、陽極は一 層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい、陽極のシート電気低抗は、好ましくは、数百Ω / 以下、より好ましくは、5~50 Ω / □程度に設定する。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~100 nm程度、より好ましくは、10~500 nm程度に設定する。

【0058】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する原である。正孔注入輸送欄は、本発明に係る化合物を例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導体、ドリアリールアシン誘導体、ボリテンン誘導体、ビラゾン誘導体、ボリン・大手で、ボリン・カーンに、カーンに、ボリン・カーンに

【0059】本発明において用いる他の正孔注入輸送機 能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体 (例えば、4,4'-ビス「N-フェニル-N-(4" メチルフェニル)アミノ〕ビフェニル、4、4'ービ ス「N-フェニル-N-(3"ーメチルフェニル)アミ ノ〕ビフェニル、4,4'ービス〔NーフェニルーNー (3"-メトキシフェニル)アミノ]ビフェニル、4. 4'-ビス(N-フェニル-N-(1"-ナフチル)ア ミノ〕ビフェニル、3,3'-ジメチル-4,4'-ビ ス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミ ノ〕ビフェニル、1、1-ビス〔4'-[N、N-ジ (4"-メチルフェニル) アミノ] フェニル] シクロヘ キサン、9、10-ビス [N-(4'-メチルフェニ (N) -N-(4"-n-プチルフェニル) アミノ) フェナントレン、3、8-ビス(N.N-ジフェニルアミ ノ) -6-フェニルフェナントリジン、4-メチルー N, N-ビス(4", 4"'-ビス(N', N'-ジ (4-メチルフェニル)アミノ] ビフェニル-4-イ ル) アニリン、N, N' ービス (4-(ジフェニルアミ ノ) フェニル 3 - N, N' - ジフェニル - 1, 3 - ジア ミノベンゼン、N、N'-ビス「4-(ジフェニルアミ ノ)フェニル] - N, N' -ジフェニル-1, 4-ジア ミノベンゼン、5,5"ービス〔4-(ビス[4-メチ ルフェニル] アミノ)フェニル <math>] -2, 2':5',2"-ターチオフェン、1、3、5-トリス(ジフェニ ルアミノ) ベンゼン、4、4'、4"-トリス(N-カ ルバゾイル)トリフェニルアミン、4,4',4"-ト リス (N-(3" '-メチルフェニル)-N-フェニル アミノ)トリフェニルアミン、4,4',4"-トリス 「N. N-ビス(4" '-tert-ブチルビフェニル-

4""ーイル)アミノ)トリフェニルアミン、1、3、 5ートリス(Nー(4'ニジフェニルアミノフェニル トNーフェニルアミノベンゼンなど)、ポリチオフェン およびその誘導体、ポリートービニルカルバール誘導 体がより好ましい。本発明に係る化合物Aと他の正孔注 入輸送機能を有する化合物を併用する場合。正孔注入輸 送層中に占める本発明に係る化合物Aの割合は、好まし くは、0.1~40重優が限度に調製する。

【0060】発光層4は、正孔および電子の注入機能、 それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を 牛成させる機能を有する化合物を含有する層である。発 光層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の発光 機能を有する化合物(例えば、アクリドン誘導体、キナ クリドン誘導体、ジケトピロロピロール誘導体、多環芳 香族化合物「例えば、ルブレン、アントラセン、テトラ セン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカシクレン、コ ロネン、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフ ェニルシクロペンタジエン、9、10-ジフェニルアン トラセン、9、10-ビス(フェニルエチニル)アント ラセン、1、4ービス(9'-エチニルアントラセニ ル)ベンゼン、4,4'ービス(9"ーエチニルアント ラセニル) ビフェニル〕、トリアリールアミン誘導体 「例えば、正孔注入輸送機能を有する化合物として前述 した化合物を挙げることができる〕、有機金属錯体〔例 えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ビ ス(10-ベンゾ[h] キノリノラート) ベリリウム、2 - (2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾオキサゾールの 亜鉛塩、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾチア ゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩、 3-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロキシフラ ボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミ ニウム塩〕、スチルベン誘導体〔例えば、1,1,4, 4ーテトラフェニルー1、3ープタジエン、4、4'ー ビス(2,2-ジフェニルビニル)ビフェニル、4, 4'-ビス[(1,1,2-トリフェニル)エテニル] ビフェニル〕、クマリン誘導体〔例えば、クマリン1、 クマリン6、クマリン7、クマリン30、クマリン10 6、クマリン138、クマリン151、クマリン15 クマリン153、クマリン307、クマリン31 クマリン314、クマリン334、クマリン33 8. クマリン343. クマリン5001. ピラン誘導体 〔例えば、DCM1、DCM2〕、オキサゾン誘導体 「例えば、ナイルレッド」、ベンゾチアゾール誘導体、 ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導 体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリー N-ビニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオフ ェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導 体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニレン ビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレンビニレン およびその誘導体、ポリターフェニレンビニレンおよび

その誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導 体、ボリチエニレンビニレンおよびその誘導体など)を 少なくとも1種用いて形成することができる。本発明の 有機電界発光素子においては、発光層に本発明に係る化 合物Aを含有していることが好ましい。本発明に係る化 合物Aと他の発光機能を有する化合物を併用する場合。 発光層中に占める本発明に係る化合物Aの割合は、好ま しくは、0.001~99.999重量%程度、より好 ましくは、0.01~99.99重量%程度。さらに好 ましくは、0.1~99.9重量%程度に調製する。 【0061】本発明において用いる他の発光機能を有す る化合物としては、発光性有機金属錯体がより好まし い。例えば、J. Appl. Phys., 65, 3610 (1989) 、特開 平5-214332号公報に記載のように、発光層をホ スト化合物とゲスト化合物(ドーパント)とより構成す ることもできる。本発明に係る化合物Aを、ホスト化合 物として用いて発光層を形成することができ、さらに は、ゲスト化合物として用いて発光層を形成することも

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配 (Q) $_2-A$ 1-O-L

(Q) 2 - A1

(式中、Qは置換8ーキノリノラート配位子を表し、O ーしはフェノラート配位子であり、しはフェニル部分を

(式中 Oは置換8-キノリノラート配位子を表す) 【0063】発光性有機金属錯体の具体例としては、例 えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ト リス(4-メチル-8-キノリノラート)アルミニウ ム、トリス(5-メチル-8-キノリノラート)アルミ ニウム、トリス(3、4-ジメチル-8-キノリノラー ト)アルミニウム、トリス(4,5-ジメチル-8-キ ノリノラート)アルミニウム、トリス(4,6-ジメチ ルー8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メ チル-8-キノリノラート) (フェノラート) アルミニ ウム ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル -8-キノリノラート)(3-メチルフェノラート)ア ルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (4-メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラ ート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノ ラート)(3-フェニルフェノラート)アルミニウム、 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニ ルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート)(2,3-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラー ト) (2. 6ージメチルフェノラート) アルミニウム。 ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(3,4-ジ メチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル -8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラー できる。本発明に係る化合物Aを、ゲスト化合物として 用いて発光層を形成する場合。ホスト化合物としては、 例えば、前記の他の発光振幅をする化合物を挙げると とができ、例えば、発光性有機金属錯体またはトリアリ ールアミン誘導体はより好ましい。この場合、発光性有 金 属錯体またはトリアリールアミン誘導体に対して、 一般式(1)で表される化合物を、好ましくは、0.0 01~40重量%程度、より好ましくは、0.01~3 0重量%程度、特に好ましくは、0.1~20重量%程度 度使用する。

(a) 位子を表す)

(b)

含む炭素数6~24の炭化水素基を表す)

 $(Q)_{3} - A1 - O - A1 - (Q)_{3}$ (c) ト) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラ ート)(3,5-ジ-tert-ブチルフェノラート)アル ミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2,6-ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2,4,6-トリフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2, 4, 6-トリメチ ルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート)(2,4,5,6ーテトラメチルフ ェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キ ノリノラート) (1ーナフトラート) アルミニウム、ビ ス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-ナフトラ ート) アルミニウム ビス (2.4-ジメチルー8-キ ノリノラート) (2-フェニルフェノラート) アルミニ ウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2.4-ジメチル-8-キノリノラート)(4-フェ ニルフェノラート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメ チルー8-キノリノラート)(3.5-ジメチルフェノ ラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチルー8-キノリノラート)(3,5-ジ-tert-ブチルフェノラ ート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノ ラート)アルミニウムーμーオキソービス(2-メチル -8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム-ルーオ キソービス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)

アルミニウム、ビス(2-xチルー4-xチルー8-キ ノリノラート)アルミニウム -x オナービス(2-x チルーターキ・フリノラート)アルミニウム 、ビス(2-x チルー4-x トキンー8-キ フリノラート)アルミニウム 、ビス(2-x チルー4-x トキンー8-キ フリノラート)アルミニウム -x キシー8-キ フリノラート)アルミニウム 「2-x チルー2-x キンティー2-x キンテ

【0064】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注 入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する 機能を有する化合物を含有する層である。電子注入輸送 層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の電子注 入輸送機能を有する化合物(例えば、有機金属錯体〔例 えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ビ ス(10-ベンゾ[h] キノリノラート) ベリリウム、5 - ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシ フラボンのアルミニウム塩〕、オキサジアゾール誘導体 [例えば、1,3-ビス〔5'-(p-tert-ブチルフ ェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2'-イ ル〕ベンゼン〕、トリアゾール誘導体〔例えば、3-(4'-tert-ブチルフェニル)-4-フェニル--5 (4"ービフェニル)ー1、2、4ートリアゾー ル〕、トリアジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘 導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、 ニトロ置換フルオレノン誘導体、チオピランジオキサイ ド誘導体など)を少なくとも1種用いて形成することが できる。本発明に係る化合物Aと他の電子注入輸送機能 を有する化合物を併用する場合、電子注入輸送層中に占 める本発明に係る化合物Aの割合は、好ましくは、O. 1~40重量%程度に調製する。本発明においては、本 発明に係る化合物Aと有機金属錯体〔例えば、前記一般 式(a)~一般式(c)で表される化合物〕を併用し て、電子注入輸送層を形成することは好ましい。

【0065】陰極6としては、比較的仕事限数の小さい 金属、合金または電気電響性化合物を電傷物質として使 用することが好ましい、陰極に使用する電極物質として は、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナ トリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マ グネシウム、マグネシウムー銀合金、アグネシウムーインジウム合金、インジウム、ルチニウム、アルミニウム、アルミニウム ーリチウム合金、アルミニウムーカルンウム合金、アル ミニウムーマグネシウム合金、グラファイト護閲等を挙 げることができる。これらの電配物質は、単単で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。降極は、これらの電極物質を、例えば、素雑法、スパックリング法、イオン化素着法、イオンブレーティング法、クラスターイオンビーが洗等の方法により、電子注入輸送圏の上に散成することができる。また、降極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極のシート電気抵抗、数百Ω/□以下に設定するのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極物質の特にもよるが、一般に、5~1000m程度、より好ましくは、10~500m程度に設定する。尚、有機電界発光器の少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように隔極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

【0066】また、本発明の有機電界発光素子において は、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャー が含有されていてもよい。一重項酸素クエンチャーとし ては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、 ニッケル錯体 ジフェニルイソベンゾフランなどが挙げ られ、特に好ましくは、ルブレンである。一重項酸素ク エンチャーが含有されている層としては、特に限定する ものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸 送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。 尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャー を含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させ てもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光 層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有さ せてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量として は、含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成す る全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.0 5~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量% である。

【0067】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例 えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例え ば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、 バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・プロゼ ット法、インクジェット法など)により薄膜を形成する ことにより作製することができる。真空蒸着法により、 各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定する ものではないが、10-5Torr程度以下の真空下で、50 ~600℃程度のボート温度(蒸着源温度)、-50~ 300℃程度の基板温度で、0.005~50nm/se c 程度の蒸着速度で実施することが好ましい。この場 合。正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層 は、真空下で、連続して形成することにより、諸特性に 一層優れた有機電界発光素子を製造することができる。 真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入

輸送層等の各層を、複数の化合物を用いて形成する場合、化合物を入れた各ポートを個別に温度制御して、共 蒸着することが好ましい。

【0068】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。正 孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用し うるバインダー樹脂としては、例えば、ポリーNービニ ルカルバゾール、ポリアリレート、ポリスチレン、ポリ エステル、ポリシロキサン、ポリメチルアクリレート、 ポリメチルメタクリレート、ポリエーテル、ポリカーボ ネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、 ボリバラキシレン、ボリエチレン、ボリエチレンエーテ ル、ポリプロピレンエーテル、ポリフェニレンオキサイ ド、ポリエーテルスルフォン、ポリアニリンおよびその 誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニ レンビニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよび その誘導体、ボリチエニレンビニレンおよびその誘導体 等の高分子化合物が挙げられる。バインダー樹脂は、単 独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。 【0069】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、適当な有機溶媒(例えば、ヘキサン、オクタン、 デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メ チルナフタレン等の炭化水素系溶媒、例えば、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シ クロヘキサノン等のケトン系溶媒、例えば、ジクロロメ タン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロエ タン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロ ベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロ ゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、酢酸アミル等のエステル系溶媒、例えば、メタノー ル、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノ ール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセロ ソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコール等のア ルコール系溶媒、例えば、ジブチルエーテル、テトラヒ ドロフラン、ジオキサン、アニソール等のエーテル系溶 媒、例えば、N、N-ジメチルホルムアミド、N、N-ジメチルアセトアミド、1-メチル-2-ピロリドン、 1,3-ジメチル-2-イミダゾリジノン、ジメチルス ルフォキサイド等の極性溶媒)および/または水に溶 解、または分散させて塗布液とし、各種の塗布法によ り、薄膜を形成することができる。

【0070】前、分散する方法としては、特に限定する ものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ベ イントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を 用いて微粒子状に分散することができる。 弦布液の濃度 に関しては、特に限定するものではなく、実施する弦布 法により、所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設 定することができ、一根には、0.1~50重量%程 度、好ましくは、1~30重量%程度の溶液濃度である。高、バインゲー樹脂を使用する場合、その使用量に 関しては、特に限定するものではないが、一般の を層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場合には、各成分の総量に対して)、5~999重量% 程度、好ましくは、10~99重量%程度、より好まし くは、15~90重量%程度に設定する。

【0071】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層 の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般 に、5nm~5µm程度に設定することが好ましい。 尚、作製した素子に対し、酸素や水分等との接触を防止 する目的で、保護層(封止層)を設けたり、また素子 を、例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオ イル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカ ボン油などの不活性物質中に封入して保護することが できる。保護層に使用する材料としては、例えば、有機 高分子材料(例えば、フッ素化樹脂、エポキシ樹脂、シ リコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ボリスチレ ン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポ リイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリ エチレン、ポリフェニレンオキサイド)、無機材料(例 えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶 緑性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、 金属硫化物) さらには光硬化性樹脂などを挙げること ができ、保護層に使用する材料は、単独で使用してもよ く、あるいは複数併用してもよい。保護層は、一層構造 であってもよく、また多層構造であってもよい。

【0072】また、電極に保護機として、例えば、金属 酸化膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜 を設けることもできる。また、例えば、陽極の表面に、 例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香飯アミン誘 薄体、フタロシアニン誘導体(例えば、卵フタロシアニ ン)、カーボンかの成る界面で中間層)を設した としてきる。さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、 例えば、酸、アンモニアン治酸化水素、あるいはプラズ マで処理して使用することもできる。

【0073】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直 流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型また は交流駆動型の素子としても関することができる。 尚、印加電圧は、一般に、2~30V程度である。本発 明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型上源、各種 の表表素子、各種の表示素子、各種の概識、各種のセン サーなどに使用することができる。

[0074]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、勿論、本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例1

厚さ200 nmの I T O透明電極 (陽極) を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超

音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス[N-フェニ ルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ] ビフェニル を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフ ェノラート)アルミニウムと例示化合物番号A-1の化 合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 O. 2 nm/sec で50nmの厚さに共変着(重量比100:0.5) し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラー ト) アルミニウムを、蒸着速度O、2nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにそ の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 O. 2 nm/se c で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して 陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、素着は、 蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機 電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印 加したところ、55mA/cm2の電流が流れた、輝度 2.4.7.0 c.d / m² の赤色の発光が確認された。

【0075】実施例2~16

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物 番号A-1の化合物を使用する代わりに、例示化合物番 号A-3の化合物(実施例2)、例示化合物番号A-5 の化合物(実施例3)、例示化合物番号A-8の化合物 (実施例4)、例示化合物番号A-10の化合物(実施 例5)、例示化合物番号A-10の化合物(実施 6)、例示化合物番号A-20の化合物(実施例 6)、例示化合物番号A-20の化合物(実施例 例示化合物番号A-20の化合物(実施例 の示化合物番号A-24の化合物(実施例 の所化合物番号A-25の化合物(実施例 の所化合物番号A-25の化合物(実施例 の所化合物番号A-25の化合物(実施例 の所化合物番号A-25の化合物(実施例 の所化合物番号A-25の化合物(実施例 の所化合物番号A-25の化合物(実施例)、例示化合物番 号A-27の化合物(実施例10)、例示化合物番号A-32の化合物(実施例11)、例示化合物番号B-1 の化合物(実施例12)、例示化合物番号B-1 の化合物(実施例13)、例示化合物番号C-10化合物(実施例15)、例示化合物番号C-10化合物(実施例15)、例示化合物番号C-10の化合物(実施例16)、実施例1に記載の方法により有機電界発光業子を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、赤色の発光が下端された。さらにその特性を調べ、結果を第1表(表1)に示した。

【0076】比較例1

集議例1において、発光層の形成に際して、例示化合物 番号A-1の化合物を使用せずに、ビス (2 ーメチルー 8-キノリノラート) (4 ーフェニルフェノラート)ア ルミニウムだけを用いて、50 n mの厚さに素着し、発 階層とした以外は、実施例1に記載の方法により有機電 界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、1 2 Vの直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認さ れた。さらにその特性を調べ、結果を第1表(表1)に 示した。

【0077】比較例2

実施例1において、発光層の形成に際して、例示化合物 番号A - 1の化合物を使用する代わりに、Nーメチル-ニーメトキシアクリドンを使用した以外は、実施例1に 記載の方法により有機電界条化業子を作製した。この森 子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したとこ ろ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、 結果を第1表(表1)に示した。 【0078】

【表1】

第1表

有機電界	輝度	電流密度
発光素子	, , , , , ,	(mA/cm²)
実施例 2	2460	5 5
実施例3	2430	5 2
実施例4	2520	5 5
実施例 5	2460	5 6
実施例 6	2540	5 2
実施例7	2540	5 3
実施例8	2320	5 2
実施例 9	2480	5 4
実施例10	2520	5 2
実施例11	2530	5 3
実施例12	2460	5 5
実施例13	2470	5 2
実施例14	2510	5 4
実施例15	2 4 5 0	5 3
実施例16	2500	5 6
比較例1	1170	8 2
比較例2	1550	7 4

【0079】実施例17

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス[N-フェニ ルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ] ビフェニル を、蒸着速度0,2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフ ェノラート)アルミニウムと例示化合物番号A-2の化 合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比100:1.0) し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラー ト) アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにそ の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度O.2nm/se c で200nmの厚さに共素着(重量比10:1)して 陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、 蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機 電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印 加したところ、58mA/cm2の電流が流れた、輝度 2470 c d/m2 の赤色の発光が確認された。

【0080】実施例18

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ

ス基板を、中性洗剤 アセトン エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極に、4、4'ービス「Nーフェニル -N-(3"-メチルフェニル)アミノ] ビフェニル を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス (8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 A-4の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比100: 2.0) し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリ ノラート)アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さ らにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2n m/sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10: 1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、 蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製 した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流 電圧を印加したところ、57mA/cm2 の電流が流れ た。輝度2480cd/m2の赤色の発光が確認され

【0081】実施例19

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ

らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス[N-フェニ ルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ] ビフェニル を、蒸着速度0、2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウ ム-μ-オキソービス(2,4-ジメチル-8-キノリ ノラート)アルミニウムと例示化合物番号A-7の化合 物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で 50nmの厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、 発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)ア ルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの 厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上 に、マグネシウムと銀を、蒸着速度O.2nm/sec で 200 nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極 とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着 槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界 発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加し たところ、60mA/cm2 の電流が流れた。輝度25 20 c d/m2 の赤色の発光が確認された。

【0082】実施例20

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4、4'、4"ートリス「N - (3" '-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ) トリフェニルアミンを、蒸着速度0.1nm/sec で3 ① nmの厚さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次 いで、その上に、4,4'-ビス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ]ビフェニルを、蒸着 速度0.2nm/sec で45nmの厚さに蒸着し、第二 正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8) ーキノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号B-2の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度O.2nm /sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比100:1. 0)し、発光層とした。さらにその上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度0.2nm /sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とし た。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で200 nmの厚さに共素着(重量比 10:1)して降極とし、有機電界発光素子を作製し た。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施し た。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下。1.2 Vの直流電圧を印加したところ、58mA/cm2 の電 流が流れた。輝度2720cd/m2の赤色の発光が確 認された。

【0083】実施例21

厚さ200nmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス(N-フェニ ルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ] ビフェニル を、蒸着速度O.2nm/secで75nmの厚さに蒸着 1. 正孔注入輸送層とした、次いで、その上に、トリス (8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 C-4の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比100: 4.0)し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。さ らにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 n m/sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10: 1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、 蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製 した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14 Vの直流 電圧を印加したところ、52mA/cm2 の電流が流れ た。輝度1860cd/m2の赤色の発光が確認され た。

【0084】実施例22

厚さ200 nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4、4'-ビス「N-フェニ ルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ] ビフェニル を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス (8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 C-12の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0. 2nm/sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比10 0:1.0)し、発光層とした。次いで、その上に、 1,3-ビス [5'-(p-tert-ブチルフェニル)- 3、4-オキサジアゾール-2'-イル〕ベンゼン を、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに蒸着 し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシ ウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で200nmの 厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電 界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態 を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、 乾燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印加したところ、4 8mA/cm² の電流が流れた。輝度1920cd/m 2 の赤色の発光が確認された。

【0085】実施例23

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ

らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス[N-フェニ ルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ] ビフェニル を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、例示化 合物番号A-3の化合物を、蒸着速度O、2nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、そ の上に、1、3-ビス〔5'~(p-tert-ブチルフェ ニル) −1, 3, 4−オキサジアゾール−2' −イル} ベンゼンを、蒸着速度0,2nm/sec で50nmの厚 さに萎着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、 マグネシウムと銀を 蒸着速度0.2nm/sec で20 0 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極と し、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽 の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発 光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印加した ところ、48mA/cm2 の電流が流れた。輝度178 0 c d / m² の赤色の発光が確認された。

【0086】実施例24

厚さ200nmのITO透明電板(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、例示化合物番号A-25の化 合物を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nmの厚さに 蒸着し、発光層とした。次いで、その上に、1,3-ビ ス[5' - (p-tert-ブチルフェニル) - 1, 3, 4-オキサジアゾール-2'-イル〕ベンゼンを、蒸着速 度0.2 nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注 入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀 を 蒸着速度0.2 nm/sec で200 nmの厚さに共 蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素 子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保った まま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲 気下、17Vの直流電圧を印加したところ、50mA/ cm2 の電流が流れた。輝度1260cd/m2 の赤色 の発光が確認された。

【0087】実施例25

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ

ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後 蒸着槽を3×10-6Torrに減圧した。ま ず、ITO透明電極上に、4,4',4"-トリス(N (3"'ーメチルフェニル)ーNーフェニルアミノント リフェニルアミンを蒸着速度(). 1 nm/secで50n mの厚さに萎着し、第一正孔注入輸送層とした。次い で、4、4'-ビス[N-フェニル-N-(1"-ナフ チル)アミノ]ビフェニルと例示化合物番号A-1の化 合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で、20nmの厚さに共蒸着(重量比100:5)し、 第二正孔注入輸送層を兼ねた発光層とした。次いで、そ の上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム を、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに共蒸 着(重量比100:1.0)し、電子注入輸送層とし た。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着(重量比 10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施し た。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15 Vの直流電圧を印加したところ、65mA/cm2の電 流が流れた。輝度2960cd/m2の赤色の発光が確 認された。

【0088】実施例26~32

実施例25において、例示化合物番号A-1の化合物を 使用する代わりに、例示化合物番号A-2の化合物(実 施例26)、例示化合物番号A-7の化合物(実施例2

- 7)、例示化合物番号A-10の化合物(実施例2
- 8)、例示化合物番号A-19の化合物(実施例2
- 9)、例示化合物番号A-22の化合物(実施例3

○)、例示化合物番号C-7の化合物(実施例31)、 例示化合物番号C-10の化合物(実施例32)を使用 した以外は、実施例25に記載の方法により有機電界発 光素子を作製した。それぞれの薬子に、乾燥雰囲気下、 12Vの直流電圧を印加したところ、赤色の発光が確認 された。さらにその特性を調べ、結果を第2表(表2) に示した。

[0089]

[表2]

第2表

有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(c d/m²)	(mA/cm²)
実施例26	2860	5 6
実施例27	2920	5 4
実施例28	2780	58
実施例29	2850	5 6
実施例30	2940	5 5
実施例31	2870	5 7
実施例32	2880	5 6

【0090】実施例33

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波浩浄した。その基板を築素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリ-N-ビニルカルバゾール(重量平均分子量1 50000), 1, 1, 4, 4-テトラフェニルー1, 3-ブタジエン(青色の発光成分)、クマリン6「 (2'ーベンゾチアゾリル)-7-ジエチルアミノク マリン" (緑色の発光成分) 〕、および例示化合物番号 A-13の化合物を、それぞれ重量比100:5:3: 2の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用い て、ディップコート法により、400nmの厚さの発光 層を形成した。次に、この発光層を有するガラス基板 を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3 ×10-6Torrに減圧した。さらに、発光層の上に、3-(4'-tert-ブチルフェニル)-4-フェニル--5 - (4"-ビフェニル)-1,2,4-トリアゾール を、蒸着速度0.2nm/sec で20nmの厚さに蒸着 した後、さらにその上に、トリス(8-キノリノラー ト) アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で30 nmの厚さに蒸着し電子注入輸送層とした。さらにその 上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 nm/sec で200 nmの厚さに共業着 重量比10:1) して除 値とし、有機電界発光業子を作製した。倘、蒸着は、蒸 着槽の減圧が整保ったまま実施した。作製した有機電 界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加 したところ、74mA/cm²の電流が流れた。輝度1 370cd/m²の白色の発光が確認された。 【0091】実験例34~88

実施例33において、例示化合物番号A-13の化合物 を使用する代わりに、例示化合物番号A-15の化合物 (実施例34)、例示化合物番号A-26の化合物(実 施例35)、例示化合物番号A-30(実施例36)の 化合物。例示化合物番号A-30(実施例37)の化合 物、例示化合物番号A-30(実施例37)の化合 物、例示化合物番号A-30(実施例38)の化合物の 化合物を使用した以外は、実施例33に記載の方法によ り有機電界光光素子を作製した。それぞれの素子に、乾 候芽囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ白色の 発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第3 表(表3)に示した。 [10092]

【表3】

第3表

有機電界 発光素子	輝度 (cd/m²)	電流密度 (mA/cm²)
実施例34	1350	7 4
実施例35	1280	7 2
実施例36	1370	7 7
実施例37	1320	7 4
実施例38	1380	7 5

【0093】実施例39

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ

らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ボリーNービニルカルバゾール(重量平均分子量 1 50000)、1、3ービス〔5'-(p-tert-ブチ ルフェニル)-1、3、4-オキサジアゾールー2'- イル)ペンゼンおよび例示化合物番号A - 20の化合物を、それぞれ重量比100:30:10割合で含有する

3面量%ジプロロエタン溶液を肝いて、ディップコート

法により、300nmの厚さの発光層を形成した。次
に、この発光層を有するガラス基板を、蒸者設置の基板
ルルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-67crrに減圧
した。さらに、発光層の上に、マグネシウムと線を、蒸 着速度0.2nm/secで200nmの厚芯に共業者

(重量比10:1)して酸酸とし、有機電界光光素子
作製した、作製した有機電界光光素子
に、製化等の電流電圧を印加したところ、76mA/c

m²の電流が流れた、離度1360cd/m²。の赤色の 発光が確認とれた。

【0094】比較例3

実施例3のにおいて、発光層の形成に際して、例示化合 物番号A-29の化合物を使用する代わりに、1、1、 4、4-7トラフェンンクジエンを使用した以外は、 実施例3のに記載の方法により有機電界発光条子作製 した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、86mA/cm²の 電流が洗れた。輝度680cd/m²の青色の発光が確 認された。

【0095】実施例40

厚さ200 nmの1 T つ適明電隆 (陽隆) を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超高、高波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて破し、さらにUVノイゾン洗浄した。次に、1 T つ適明電極上に、ポリカーボネート (重量平均分子量50000) よ 4、4 'ーセス(NーフェニルーNー(3" メチルフェニル) アミノ) ビフェニル、トリス(8ーキノリノラート) アルミニウムおよび例示化合物等得へ30の化合物を、それぞれ重量比100140:6011の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、300 nmの厚をの発光層を形成で、ディップコート法により、300 nmの厚をの発光層を影響装置の基板ホルゲーに固定した後、蒸着槽を3×10°T0でに護圧した。さらに、発光層の上に、マグネシウムと

共素着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光 素子を作製した、作製した有機電界発光素子に、乾燥雰 囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、66mA /cm²の電流が流れた。輝度770cd/m²の赤色 の発光が確認された。

[0096]

【発明の効果】本発明により、発光輝度が優れた有機電 界発光素子を提供することが可能になった。 【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例(A)の概略構造図で

ある。 【図2】有機電界発光素子の一例(B)の概略構造図で

ある。 【図3】有機電界発光素子の一例(C)の顧略構造図で

ある。 【図4】有機電界発光素子の一例(D)の概略構造図で

ある。 【図5】有機電界発光素子の一例(E)の概略構造図で

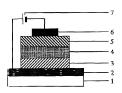
ある。 【図6】有機電界発光素子の一例(F)の概略構造図で

ある。 【図7】有機電界発光素子の一例(G)の概略構造図で

【図8】有機電界発光素子の一例(H)の概略構造図で ある。

- 【符号の説明】
- 1 基板
- 2 陽極
- 3 正孔注入輸送層
- 3 a 正孔注入輸送成分
- 4 発光層
- 4 a 発光成分
- 5 電子注入輸送層
- 5" 電子注入輸送層
- 5 a 電子注入輸送成分
- 6 陰極
- 7 雷源

【図1】



【図2】

